

{joomplu:1591}В период с 8 по 14 сентября 2019 года сотрудники НИЯУ МИФИ и АО «ЭНПО СПЭЛС» **Громов Д.В., Жидков Н.М., Селищев И.А.** приняли участие с четырьмя устными докладами в 29-ой Международной Крымской конференции «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» (КрыМиКо-2019), которая проходила на территории Севастопольского государственного университета в городе Севастополе, Республика Крым, Россия.

В работе конференции приняли участие более 300 ученых и специалистов из России, Белоруссии, Китая и Украины. На трех пленарных и 36-ти секционных заседаниях было представлено более 400 докладов по теоретическим, экспериментальным, производственно-технологическим, прикладным и историческим аспектам СВЧ-техники и телекоммуникационных технологий.

{joomplu:1592}

По решению программного комитета соавтор одного из докладов НИЯУ МИФИ и АО «ЭНПО СПЭЛС» – **Селищев Илья Алексеевич** был награжден дипломом за лучшую научную работу, представленную молодым ученым (аспирантом) на конференции.

Полные тексты докладов планируются к публикации в журналах ITM Web of Conferences (252 доклада),

Ural

Radio

Engineering

Journal

(33 доклада) и Инфокоммуникационные и радиоэлектронные технологии (55 докладов). Рефераты всех включенных в программу конференции докладов размещены на флеш-накопителе.

Перечень докладов сотрудников НИЯУ МИФИ и АО «ЭНПО СПЭЛС»:

Секция: Электромагнитная и радиационная стойкость материалов и ЭКБ. Руководитель

секции - проф. Громов Д.В. (НИЯУ МИФИ)

1. Долговременные эффекты восстановления характеристик полевых транзисторов с затвором Шоттки при воздействии импульсного ионизирующего излучения / Громов Д. В., Елесин В. В.

2. Влияние радиации на характеристики резонансно-туннельных диодов / Громов Д. В., Полевич С. В.

3. Долговременные параметрические сбои в быстродействующих переключателях сигналов, выполненных по E/D PHEMT технологии с проектной нормой 0,1 мкм / Кузнецов А.Г., Елесин В.В., Усачев Н.А., Чуков Г.В.

4. Первый опыт контрактного производства радиационно-стойких СВЧ усилителей по отечественной технологии рHEMT 0,5 мкм / Сотсков Д.И., Усачев Н.А., Елесин В.В., Селищев И.А., Амбуркин К.М., Кузнецов А.Г.

5. Использование вероятностных нечетких моделей при прогнозировании функциональных отказов СВЧ БИС при воздействии радиации / Барбашов В.М., Трушин Н.С.